# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-223621

(43) Date of publication of application: 12.08.1994

(51)Int.CI.

HO1B C08K

CO9D 5/24

H05K

3/12 HO5K **H05K** 3/46

(21)Application number : **05-013928** 

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

29.01.1993

(72)Inventor: HAKOTANI YASUHIKO

**ITAGAKI MINEHIRO** 

## (54) CONDUCTOR PASTE COMPOSITION

## (57)Abstract:

PURPOSE: To provide a low conductive resistance via electrode, which has no possibility of cavities inside via and ensures its adhesion to a via hole, for a ceramic multilayer wiring board which has an inside electrode made of copper and zero firing shrinkage in a plane direction.

CONSTITUTION: Conductor for via has CuO powder as conductor material, inorganic components containing Cu powder of average size 5.0-20.0µm and composed of 30.0-70.0wt.% conductor material and 30.0-70.0wt.% crystallized glass ceramic powder with the glass transition temperature higher than the glass transition temperature of insulating material, and organic vehicle composed of at least organic binder and solvent. Conductor paste composition in which the Cu powder represents 10.0-60.0wt.% of the conductor material is used.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

h

g

е

е

h

**PAT-NO:** 

JP406223621A

**DOCUMENT-IDENTIFIER:** JP 06223621 A

TITLE:

CONDUCTOR PASTE COMPOSITION

**PUBN-DATE:** 

August 12, 1994

## **INVENTOR-INFORMATION:**

NAME

**COUNTRY** 

HAKOTANI, YASUHIKO ITAGAKI, MINEHIRO

## **ASSIGNEE-INFORMATION:**

**NAME** 

**COUNTRY** 

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD N/A

**APPL-NO:** 

JP05013928

APPL-DATE: January 29, 1993

INT-CL (IPC): H01B001/16, C08K007/06, C09D005/24, H05K001/09, H05K003/12, H05K003/46

## **ABSTRACT:**

PURPOSE: To provide a low conductive resistance via electrode, which has no possibility of cavities inside via and ensures its adhesion to a via hole, for a ceramic multilayer wiring board which has an inside electrode made of copper and zero firing shrinkage in a plane direction.

CONSTITUTION: Conductor for via has <u>CuO</u> powder as conductor material, inorganic components containing Cu powder of average size 5.0-20.0µm and composed of 30.0-70.0wt.% conductor material and 30.0-70.0wt.% crystallized glass ceramic powder with the glass transition temperature higher than the glass transition temperature of insulating material, and organic vehicle composed of at least organic binder and solvent. Conductor paste composition in which the Cu powder represents 10.0-60.0wt.% of the conductor material is used.

COPYRIGHT: (C)1994, JPO& Japio

е

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-223621

(43)公開日 平成6年(1994)8月12日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>		識別記与	<b>=</b>	庁内整理番号	FΙ						技術表示箇所
H 0 1 B	1/16		Z	7244-5G							•
C 0 8 K	7/06	KCJ		7242-4 J							
C 0 9 D	5/24	PQW		7211-4 J							
H 0 5 K	1/09		Z	6921-4E			•				
	3/12		В	7511-4E							
		•		審査請求	未請求	請求項	[の数 1	OL	(全	5 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顯平5-1392	8		(71)	 出願人	000005	821			
							松下電	器産業	株式	会社	
(22)出願日		平成5年(1993)1月29日					大阪府	門真市	大字	<b>門真100</b>	6番地
				•	(72)	発明者	箱谷	靖彦			
							大阪府	門真市	大字	門真100	6番地 松下電器
		٠			産業株式会社内						
					(72)	発明者	板垣	峰広			
						•	大阪府	門真市	大字	門真100	6番地 松下電器
							産業株	式会社	内		
					(74)	代理人	弁理士	武田	元	政	

## (54) 【発明の名称 】 導体ペースト組成物

## (57)【要約】 (修正有)

【目的】 銅を内部電極とし、平面方向への焼成収縮が ゼロのセラミック多層配線基板において、ビア内部での 空隙の発生を解決し、ビア孔に確実に密着し、導体抵抗 の低いビア電極を得る。

【構成】 ビア用の導体に、導体物質としてCuO粉末と、平均粒径5.0~20.0μmのCu粉末を含み、前記導体物質30.0~70.0重量%と、ガラス転移温度が絶縁材料のガラス転移温度よりも高い温度の結晶化ガラスセラミック粉末30.0~70.0重量%からなる無機成分と、少なくとも有機バインダと溶剤よりなる有機ビヒクル成分を備え、前記Cu粉末が前記導体物質の10.0~60.0重量%を占める導体ペースト組成物を用いる。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 導体物質として酸化第二銅粉末と、平均粒径5.0~20.0μmの銅粉末を含み、前記導体物質30.0~70.0重量%と、ガラス転移温度が絶縁材料のガラス転移温度よりも高い温度の結晶化ガラスセラミック粉末30.0~70.0重量%からなる無機成分と、少なくとも有機バインダと溶剤よりなる有機ビヒクル成分を備え、前記銅粉末が前記導体物質の10.0~60.0重量%を占めることを特徴とする導体ペースト組成物。

## 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、回路基板の導体ペースト組成物に関するものであり、特に低温焼成セラミック多層配線基板(以下、MLCと略す)のビア電極材料として使用される導体ペースト組成物に関する。

#### [0002]

【従来の技術】セラミック誘電体基質に適用する導体組成物には、Au、Ag/Pd等の貴金属を用いるものと、W、Mo、Ni、Cu等の卑金属を用いる場合がある。特にセラミック多層配線基板は、この金属材料に有機バイ20ンダ、溶剤を加えてペースト状にしたものをアルミナなどの絶縁基板上にスクリーン印刷し、焼き付けて導体パターンを形成するものである。

【0003】また、セラミック多層配線基板では、これらの導体ペーストの他、絶縁材料としてセラミックやガラス粉末を有機バインダを溶かした溶剤中に分散させたものを用いて多層化する方法と、前記の絶縁粉末、有機バインダ等からなるグリーンシート上に、前記導体ペーストでパターン形成したものを積層して多層化する方法がある。

【0004】これらに使用される金属導体材料に注目すると、Au、Ag/Pdは空気中で焼成できる反面、貴金属であるためコストが高い。一方、W、Mo、Ni、Cuは、卑金属で安価であるが、焼成雰囲気を還元雰囲気か、中性の雰囲気で行なう必要がある。またW、Moでは、1500℃以上の高温焼成となる。さらに信頼性の面からAuでは、半田食われが問題となり、Ag/Pdでは、マイグレーションおよび導体抵抗が高いという問題がある。

【0005】そこで、安価で電気抵抗が低く、半田付け 40 性の良好なCuを用いるようになってきた。

【0006】例えば、米国特許第4,072,771号には、Cuペーストの組成、同じく特開昭56-93396号公報に開示されている。前者はCu粉にガラスフリットを含有する組成物、後者はガラスフリットを含まない組成物での構成が記載されている。

【0007】しかし、Cuを使う上でも課題がある。それは、Cu電極による誘電体基質への焼成は還元もしくは中性雰囲気となり、ペースト中の有機バインダの分解除去が困難となるからである。これは、窒素中の酸素濃 50

度が低いためバインダの分解が起こらず、カーボンの形で残りメタライズ性能に悪影響を及ぼす。逆に、酸素濃度が高いと、Cu電極が酸化され誘電体中に拡散して電極として機能しなくなる。そのため焼成は、窒素雰囲気中に若干の酸素をコントロールしながら供給することで行なわれる。そして、残存したカーボンが酸化銅と反応して電極層にブリスタを発生させたり、電極ー誘電体間のマッチングを悪くさせる要因となる。このようにCuペーストは、有機バインダの使用に多くの課題を有して10 いる。

【0008】そこで近年、導体材料の出発原料に酸化第二銅(CuO)を用いる新しいCu電極セラミック多層配線基板の製造方法が開発された。つまりセラミックグリーンシート上にCuO導体組成物によって配線パターンを形成し、積層の後、酸化性雰囲気中の熱処理で前記CuO導体組成物、およびセラミックグリーンシート中の有機残基を熱分解する工程と、還元雰囲気中の熱処理でCu金属に還元する工程と、窒素雰囲気でのセラミック基質の焼成を行なう工程より作成されるという構成を備えたものである。

【0009】例えば、米国特許第4,795,512号公報、同じく米国特許第4,863,683号公報に開示されている。このセラミック積層体の製造方法によれば、絶縁基板およびペースト中の有機バインダの分解除去が容易となり、かつ良好なCuのメタライズが得られる。

【0010】また、このセラミック積層体の製造方法で 用いるビア用の導体組成物としては、基板とビアとの焼 成収縮を一致させるために、CuO粉末の他にガラスフ リットと、MgO粉末、さらにAl2O3, SnO2, Ti 30 O2, MnO2のうち少なくとも1種以上を含有した無機

成分と、有機ビヒクル成分を含む導体ペーストが用いられることが提案されている。 【0011】セラミック多層配線基板は、焼成時に焼結

に伴う収縮が生じる。この焼結に伴う収縮は、使用する 基板材料およびグリーンシート組成の管理はもちろん、 粉体ロットの違いや積層条件(プレス圧力、温度)を十分 管理しても、一般に±0.5%程度の収縮誤差が存在する といわれている。この課題を解決し、内部導体に銅を用 い、平面方向の収縮がゼロのセラミック多層配線基板の 製造方法が提案されている。

【0012】また、CuOを主成分とする導体ペースト組成物で電極パターンを形成した少なくとも有機パインダ、可塑剤を含むガラス・セラミックよりなるグリーンシートを所望枚数積層した後、前記ガラス・セラミックの焼成温度では焼結しない無機組成物よりなるグリーンシートを前記ガラス・セラミック積層体の両面、もしくは片面に積層した後、これらを空気中で多層体内部の有機パインダが分解、飛散する温度で熱処理し、しかる後、水素もしくは水素と窒素の混合ガス雰囲気中で還元熱処理を行ない、さらに前記還元熱処理済み多層体を窒

3

素雰囲気中で焼結させ、しかる後、焼結しない無機組成物を取り除くことを特徴とするセラミック多層配線基板の製造方法が提案されている。

【0013】また、上記の平面方向の収縮がゼロのセラミック多層配線基板においては、ビアの焼成収縮は縦方向(基板厚み方向)にのみ起こるため、ビア孔に確実に密着した緻密な構造の信頼性の高いビア導体としては、CuOなどの導体材料とガラス転移温度が絶縁材料のガラス転移温度よりも高い結晶化ガラスセラミック粉末からなる無機成分と、有機ビヒクル成分を備えた導体ペース 10ト組成物を用いるのが適当であることが提案されている。

#### [0014]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のようなCuOを銅内部電極の出発材料にして、平面方向に収縮を起こさないセラミック多層配線基板の製造において、前記ピア用導体ペーストを用いた場合、ピア孔に確実に密着した緻密な構造の信頼性の高いビアが形成されるが、ピアの導体抵抗が高くなるという問題が生じた。

【0015】本発明は上記課題に鑑み、導体抵抗が低く、ビア孔に確実に密着した緻密な構造の信頼性の高い ビアを形成するビア用の導体ペースト組成物を提供する ことを目的とする。

#### [0016]

【課題を解決するための手段】本発明のビア用の導体ペースト組成物は、導体物質として酸化第二銅(CuO)粉末と、平均粒径5.0~20.0μmの銅(Cu)粉末を含み、前記導体物質30.0~70.0重量%と、ガラス転移温度が絶縁材料のガラス転移温度よりも高い温度の結晶化ガラスセ 30ラミック粉末30.0~70.0重量%からなる無機成分と、少なくとも有機バインダと溶剤よりなる有機ビヒクル成分を備え、前記銅(Cu)粉末が前記導体物質の10.0~60.0重量%を占めることを特徴とする。

### [0017]

【作用】本発明によれば、ビア孔を形成する絶縁材料が 焼結しビア孔が形成された後に、ビア孔内部のビア導体 材料中のガラス成分が軟化し、ビア導体が焼結するた め、ビア導体部分での断線やビア孔内部に空隙が発生せ ず、ビア孔に確実に密着した緻密な構造のビア導体が形 40 成でき、また導体物質にCu粉末を含むため、導体物質 がCuOのみの場合に比べ、導体抵抗のより低いビア電 極が形成できる。 [0018]

【実施例】以下、本発明の一実施例のセラミック多層配 線基板について図面を参照しながら説明する。図1は本 発明の一実施例のグリーンシート積層体の断面図を示 す。

【0019】まず、セラミック多層配線基板の作成方法を説明する。

【0020】基板材料のガラス・セラミックには、ガラス粉末にセラミック材料としてのアルミナ粉末を重量比で50対50とした組成物(日本電気硝子社製、MLS-27、ガラス転移温度520℃)を用いた。このガラス・セラミック粉を無機成分とし、有機バインダとしてポリビニルブチラール、可塑剤としてヂーnーブチルフタレート、溶剤としてトルエンとイソプロピルアルコールの混合液(30対70重量比)を混合し、スラリーした。

【0021】このスラリーをドクターブレード法で有機フィルム上に厚み約200μmのシート成形した。このとき、造膜から乾燥、打ち抜き、さらには必要に応じてビアホール加工を行なう各工程を連続的に行なうシステムを使用した。ビアホール径は、0.15mm々であった。

【0022】次に、内部電極用ペーストとしては、Cu O粉(京都エレックス社製, 平均粒径3μm)に、接着強度を得るためのガラスフリット(日本電気硝子社製, L S-0803ガラス粉末, 平均粒径2.5μm)を3wt%加えたものを無機成分とし、有機バインダであるエチルセルロースをターピネオールに溶かした有機ビヒクルとを加えて、3段ロールにより適度な粘度になるまで混練し作成した。

【0023】また、ビアホール電極用ペーストとしては、無機組成としてCuO粉(京都エレックス社製,平均粒径3μm),結晶化ガラスセラミック粉末(日本電気硝子社製,MLS05,ガラス転移温度670℃),Cu粉末(福田金属箔粉社製,SRC,平均粒径15μm)を、表1に示したように、Cu粉末量を種々変化させた組成で配合し、さらに有機バインダであるエチルセルロースをターピネオールに溶かした有機ビヒクルとを加えて、3段ロールにより適度な粘度になるまで混練し作成した。上記の導体ペーストを用いて導体パターンの形成およびビアホールの埋め印刷をスクリーン印刷法によって行なった。

[0024]

【表1】

	l	2	3	4	5	
導 C	0	1 5	3 5	5 5	8 0	
配合組成	CuO (#t%)	50.0	42.5	32.5	22.5	10.0
	Cu (wt%)	0.0	7.5	17.5	27.5	10.0
	ガラスセラミック(wt.%)	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
ピア	15.2	10.3	6.0	6.9	open	
ピア	良好	良好	良好	良好	断線	

【0025】次に、焼結の起こらないグリーンシートの 作成は、無機成分としてアルミナ(住友化学工業社製、 ALM-41, 平均粒径1.9µm)粉末のみを用い、前記ガ ラス・セラミック基板用グリーンシートと同様のグリー ンシート組成で、同様の方法でグリーンシート(厚み300 20 μш)を作成した。

【0026】前記導体形成済みガラス・セラミックグリ ーンシートを所定の枚数積み重ね、さらにその両面に前 記アルミナグリーンシートを重ね合わせる。この状態で 熱圧着して積層体を形成した。熱圧着条件は温度が80  $\mathbb{C}$ 、圧力は200kg/ $\mathbb{C}$ rかった。 $2 \mathbb{C}$ 1 にそのグリーンシ ート積層体の断面図を示し、1は前記基板材料のガラス セラミックによるグリーンシート層、2は内部電極層、 3はビア電極、4はアルミナによるグリーンシート層で ある。

【0027】次に、前記積層体をアルミナ96%基板上に 載せ、以下に説明する工程で焼成した。まず最初は、脱 バインダ工程である。本実施例に使用したグリーンシー ト、CuOペーストの有機バインダは、ポリビニルブチ ラールおよびエチルセルロースである。したがって空気 中での分解温度は500℃以上あればよいので、600℃の温 度で前記積層体の脱脂処理を行なった。その後、前記積 層体を水素ガス100%雰囲気中で、200℃-5時間で還元 した。このときのCu層をX線回折により分析したとこ ろ、100%Cuであることを確認した。

【0028】次に焼成工程は、メッシュベルト炉で純窒 素中900℃で1時間焼成した(900℃の保持時間は約12分 である)。このとき、基板の反りと厚み方向の焼結収縮 を助けるため、アルミナ焼結基板を載せて加圧するよう にして焼成を行なった。焼成後の積層体の表面には、未 焼結のアルミナ層が存在するため、酢酸ブチル溶剤中で 超音波洗浄を行なったところ、アルミナ層をきれいに取 り除くことができた。

【0029】この焼成後の基板は反りもなく、基板の収 縮率は0.1%以下で、また反りもなかた。基板の両面に \*50 【0034】また、ビア導体ペースト中のCu粉末の粒

\* 市販のCuペースト(デュポン社製, QP153)にて最上層 パターンをスクリーン印刷により形成、乾燥後、前記焼 成と同様に900℃で1時間焼成で行なった。

【0030】こうして得られたセラミック多層配線基板 はビア電極の抵抗を測定し、また基板断面のSEM観察 により、ビアと内部電極パターンとの接合性、ビア構造 を確認した。それらの結果を表1に示し、この表1から 明らかなように、導体物質中のCu配合量が増えるに従 ってビア電極の抵抗は低下した。

【0031】また、配合組成No.1.2.3.4につい ては、ビア導体と配線導体の接触部分での断線やビア孔 内部の空隙が発生せず、ビア孔内壁に確実に密着した緻 密な構造のビア導体が形成できた。しかし、導体物質中 のCu粉末の割合が60重量%を超えると、焼成後の基板 のビアホール体積よりビアに充填された導体組成物の焼

成体積が大きくなり、内部配線導体とビア電極の断線が 生じた。配合組成No. 4において、ピアの抵抗値が配合 組成No. 3のピアより若干高くなったのは、ピアホール とビア導体との体積のミスマッチが生じかけているため と思われる。

【0032】なお、ビア導体ペースト中の導体物質とガ ラスセラミックの比率を変化させたものを作成して、同 様にセラミック多層配線基板を製造した。このとき、導 体物質の比率が30重量%以上含有されていないビア導体 40 ペースト(ガラスセラミック成分が多い)を用いたもので は、ビア孔内部の空隙が発生せず、ビア孔内壁に確実に 密着した緻密な構造のビア導体が形成されたが、ガラス セラミック成分が多すぎるために導通が得られなかっ た。

【0033】一方、導体物質の比率が70重量%を超える ビア導体ペースト(ガラスセラミック成分が少ない)を用 いたものでは、導体の焼結収縮によりビア孔内部やビア 内部電極パターン接合部に空隙が発生し、断線も見ら れた。

径を変化させたものを作成して、同様にセラミック多層 配線基板を製造し、評価した。粒径3.0μmのCu粉を用 いた場合、基板焼成の脱バインダ工程でCuがCuOに酸 化される際の体積膨張が大きく、層間のデラミネーショ ンやビア電極破壊等が生じた。一方、粒径30μmのCu粉 を用いた場合、ペースト中へのCu粉の分散が難しく、 またビアホールへのペースト充填も十分に行なえなかっ た。

#### [0035]

and the second

【発明の効果】以上説明したように本発明の導体ペース 10 1…ガラス・セラミックのグリーンシート層、 2…内 ト組成物は、ビア孔を形成する絶縁材料が軟化し焼結し てビア孔が形成された後に、ビア孔内部のビア導体材料 中のガラス成分が軟化しビア導体が焼結するので、ビア

導体部分での断線やビア孔内部に空隙が発生せず、ビア 孔に確実に密着した緻密な構造の信頼性の高いビア導体 が形成できる。また導体物質にCu粉末を含むため、導 体物質がCuOのみの場合に比べ、導体抵抗のより低い ビア電極が形成できる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例のグリーンシート積層体の断 面図である。

#### 【符号の説明】

部電極層、 3…ピア電極、 4…アルミナのグリーン シート層。

【図1】

1 ガラスセラミックのグリーンシート層 3 ピア電松 2 內部電極層

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 ĖΙ

技術表示箇所

H 0 5 K 3/46

S 6921-4E